
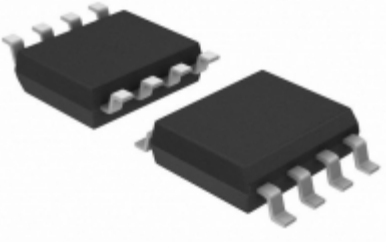
	<p><b>SI4174DY-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI4174DY-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 17A 8-SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI4174DY-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 222138 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4174DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 17A 8-SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	222138 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 17A (Tc) 2.5W (Ta), 5W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 5W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.5 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	985pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI4174DY-T1-GE3-ND

SI4174DY-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI4174DY-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4174DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4174DY-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI4176DY-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 12A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4174DY-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 17A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4174DY-T1</b> VISHAY VISHAY SOP-8</p>	 <p><b>SI4176DY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 12A 8SO</p>
 <p><b>SI4174DY-T1-E3</b> V SI4174DY-T1-E3 V</p>	 <p><b>SI4172DY-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 15A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4174DY</b> VISHAY SI4174DY VISHAY</p>	 <p><b>SI4176DY-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 12A 8SO</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ SI4160DY-T1-GE3	↔ SI4162DY	⇒ SI4162DY-T1-E3	D SI4162DY-T1-GE3	↔ SI4162DY-T1-GE3
⊖ SI4164DY	⊕ SI4164DY-T1-E3	D SI4164DY-T1-GE3	⇒ SI4164DY-T1-GE3	↔ SI4166DY
⊕ SI4166DY-T1-E3	⊖ SI4166DY-T1-GE3	⊕ SI4166DY-T1-GE3	↔ SI4168DY	↔ SI4168DY-T1-E3
D SI4168DY-T1-GE3	⊕ SI4168DY-T1-GE3	⊖ SI4170DY-T1-GE3	⊕ SI4170DY-T1-GE3	↔ SI4172DY
⇒ SI4172DY-T1-E3	↔ SI4172DY-T1-GE3	⊕ SI4172DY-T1-GE3	⊖ SI4174DY	↔ SI4174DY-T1-E3
↔ SI4174DY-T1-GE3	⇒ SI4176DY-T1-GE3	D SI4176DY-T1-GE3	⊕ Si4178DY	⊖ SI4178DY-T1-E3
⊕ SI4178DY-T1-E3	D SI4178DY-T1-GE3	⇒ SI4178DY-T1-GE3	↔ SI4186DY-T1-E3	↔ SI4188DY-T1-E3
⊖ Si4190ADY	⊕ SI4196DY-T1-GE3	↔ SI4196DY-T1-GE3	⇒ SI4200-BM	↔ SI4200-BMR
⊕ SI4200-GM	⊖ SI4200-GMR	⊕ SI4200BM	D SI4200DB-BMR	↔ SI4200DY-T1-E3
↔ SI4201-BMR	⊕ SI4201-GMR	⊖ Si4202DY	⊕ SI4205-BM	↔ SI4205-BMR

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

